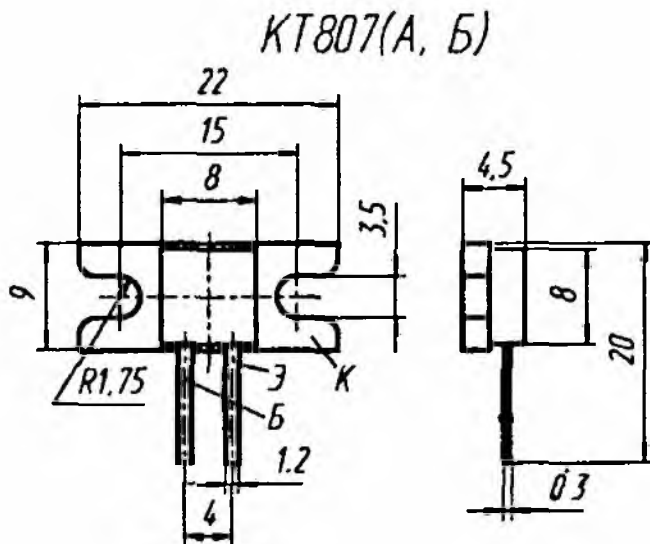


КТ807А, КТ807Б, КТ807АМ, КТ807БМ

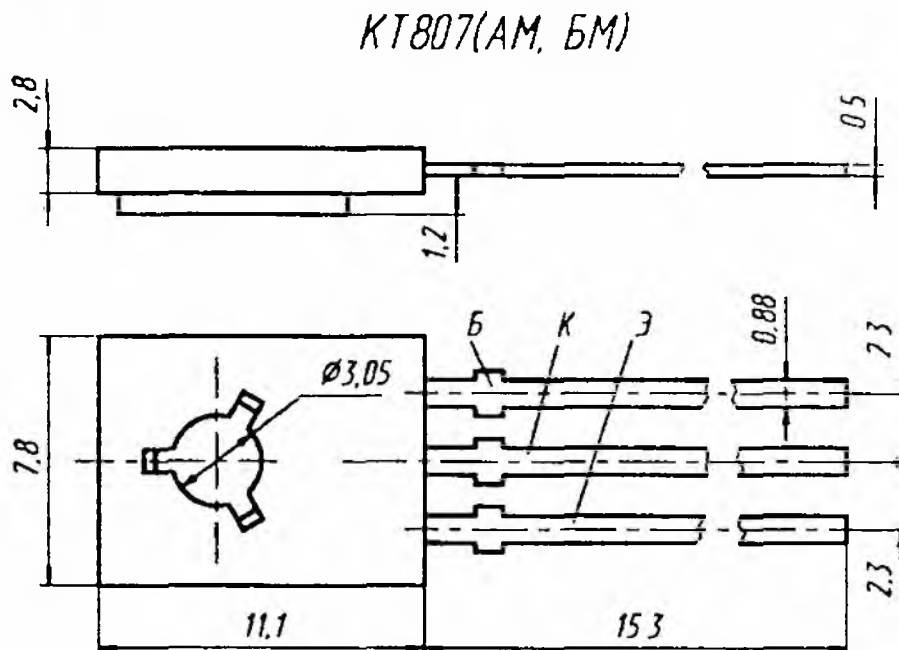
Транзисторы кремниевые мезопланарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в генераторах кадровой и строчной разверток, усилителях низкой частоты, источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металл-пластмассовом (КТ807А, КТ807Б) и пластмассовом (КТ807АМ, КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.



КТ807БМ) корпусах с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов КТ807А, КТ807Б не более 2,5 г, КТ807АМ, КТ807БМ — не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Элиз», г. Фрязино.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_{К} = 0,5 \text{ А}$:

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ807А, КТ807АМ 15...45

КТ807Б, КТ807БМ 30...100

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ807А, КТ807АМ 20...60

| | |
|---|----------|
| КТ807Б, КТ807БМ | 45...150 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ, не менее | 5 МГц |
| Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 0,1$ А, не более | 1 В |
| Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КЭ} = 100$ В, $R_{БЭ} = 10$ Ом, не более: | |
| $T = +25$ °С | 5 мА |
| $T = +85$ °С | 15 мА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4$ В, не более | 15 мА |

Предельные эксплуатационные данные

| | |
|--|--------------|
| Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ Ом или $R_{БЭ} = 1$ кОм и запирающем напряжении эмиттер—база 0,5 В | 100 В |
| Постоянное напряжение эмиттер—база | 4 В |
| Импульсное напряжение коллектор—эмиттер | 120 В |
| Постоянный ток коллектора | 0,5 А |
| Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1$ мс, $Q \geq 2$ | 1,5 А |
| Постоянный ток базы | 0,2 А |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T = -40...+70$ °С | 10 Вт |
| Тепловое сопротивление переход—корпус | 8 °С/Вт |
| Температура р-п перехода | +150 °С |
| Температура окружающей среды | -40...+85 °С |

¹ При $T_K > +70$ °С мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{K, \text{ макс}} = (150 - T_K) / R_{Т (п-к)}, \text{ Вт.}$$

Расстояние от корпуса транзистора до начала изгиба и пайки вывода не менее 5 мм. Радиус изгиба 1,5...2 мм. Пайка выводов должна осуществляться при температуре не более +250 °С в течение не более 3 с.